

—第一届
全国强磁场
学术讨论会
— 1984.10 —
浙江绍兴

THE FIRST NATIONAL SYMPOSIUM
ON HIGH MAGNETIC FIELDS
SHAO XING , CHINA

前　　言

强磁场和极低温、超高压、强辐射等一样，是一种极端物理实验条件，是近年来国际上正在迅速发展起来的、基础研究和新技术密切配合的、新的科学领域。它在能源技术、交流、工农业生产等国民经济各个领域和高能物理、受控热核反应、固体物理、材料科学、生物物理、化学和生物等学科都得到了广泛的应用，并在不断取得新的成果。

第一届全国强磁场学术讨论会于1984年10月10日至15日在浙江省绍兴市召开。本论文集收集会议论文和论文摘要31篇。内容包括：

1. 强磁场（主要是脉冲强磁场）的产生技术，磁体设计；
2. 磁场测量和物性测量方法；
3. 强磁场下的物性研究；
4. 强磁场在生产技术和经济建设中的应用。

近年来，随着我国科技事业的发展和国民经济建设事业的需要，不少单位已经建立10T左右的超导磁场和高达40T的脉冲强磁场；正在研制高达20T的混合型强磁场装置，在磁性材料、半导体材料、超导材料研究等领域取得初步成果；磁选、磁成形、磁疗等方面的应用正在不断扩大。

本论文集的出版得到了中国科学院物理研究所、北京大学、中国科学技术大学、中国科学院等离子体物理研究所、南京大学、湖南新化电子磁件厂等单位的赞助、深表谢意。

编　者

第一届全国强磁场学术讨论会

主办单位 中国物理学会

承办单位 中国科学院物理研究所
北京大学
中国科学院合肥等离子体物理研究所
中国科学技术大学
南京大学

赞助单位 中国科学院物理研究所
北京大学
中国科学院合肥等离子体物理研究所
中国科学技术大学
南京大学

第一届全国强磁场学术讨论会组织机构

组织委员会

主席 尹道乐

委员 (以姓氏笔划为序)

李传义

杨伏明

胡香泉

胡洪铨

张裕恒

高秉均

曹华伦

秘书 杨伏明 (兼)

赵汐潮

出版委员会

主席 尹道乐

委员 杨伏明

李传义

张裕恒

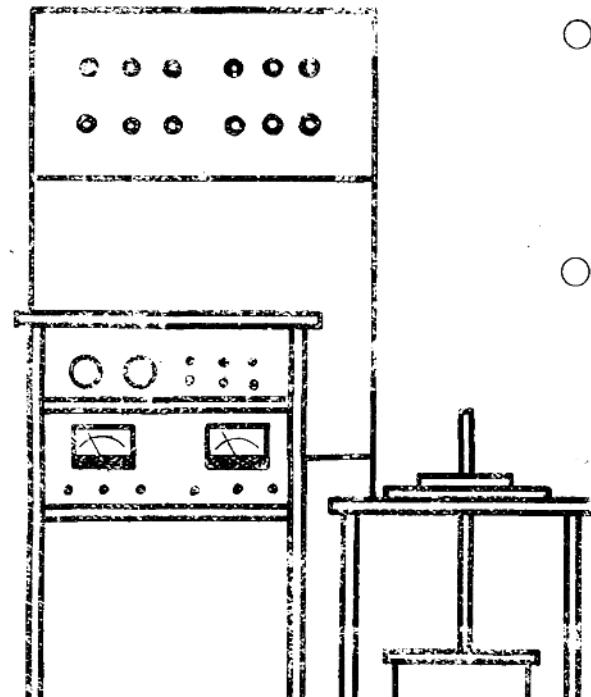
采用科学院物理所强磁场实验室科研成果

脉冲强磁场自动测试仪

提供 40T, 20T, 10T, 5T

各种规格脉冲强磁场

准确 安全 可靠



湖南一新化
新化电子磁件厂

地址：湖南新化
电报挂号：0208
电话：551

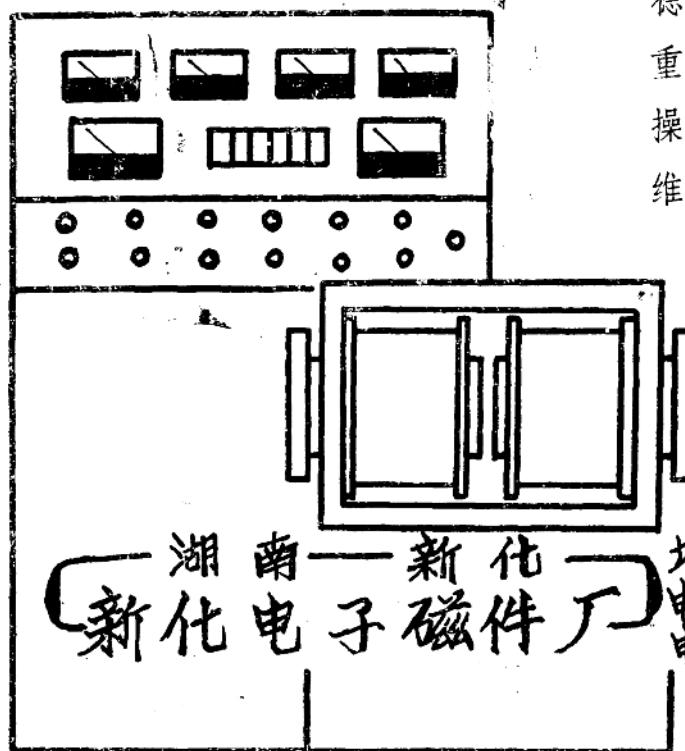
○可用于磁学，超导，
低温，电学，光学等脉冲强磁场
测量。

○可根据用户要求设计
和提供强磁场装
置各类部件，磁
体，电源，计算
机控制系统，自
动记录系统。

H E X Y 系列
永磁材料快速测定仪

适用于工厂、企业快速测定铁氧体永磁
及稀土永磁的主要磁性能： B_r ， H_c
 $(BH)_{max}$

直 接 读 出
数 字 显 示
稳 定 可 靠
重 复 性 好
操 作 简 单
维 修 方 便



目 次

前 言

第一届全国强磁场学术讨论会主办、承办、赞助单位	(i)
第一届全国强磁场学术讨论会组织机构	(ii)
采用科学院物理所强磁场实验室科研成果	
——脉冲强磁场自动测试仪	(iii)
HEXY系列永磁材料快速测定仪	(iv)
第一届全国强磁场学术讨论会论文集内容	

强磁场的产生

脉冲强磁场的设计理论和实验(邀请报告)	张裕恒 (1)
脉冲强磁场磁体的设计	张志鹏 (15)
41T 脉冲强磁场的应力分析	施嘉标 潘引年 王伟 (23)
41T 磁体磁场形态及其电动力的计算	施嘉标 潘引年 王伟 (27)
谐振式恒流充电电源	
.....赵汝文 张敏生 李银安 吴永生 吴成 叶茂福 赵汐潮 杨伏明 (30)	
磁成形技术及其应用	叶茂福 吴成 李银安 张宝珍 (33)
实验室用铌钛超导强磁体的研究	陈宗智 单贤琦 吴秀兰 潘千里 周毅 (36)
实验室用Nb ₃ Sn小孔径超导磁体的研制	李世恕 李山林 (44)
20T稳定强磁场实验装置	强磁场研究室 (46)
具有平顶的脉冲强磁场成形网路设计	李银安 吴成
.....叶茂福 张敏生 江德仪 陆龙龙 张宝珍 赵汝文 赵汐潮 杨伏明 (51)	

测量技术

脉冲强磁场测量系统的基本方程及其跟踪讯号峰值的条件	曾广达 叶妙元 (52)
强磁场下的法拉第效应	高瑞芬 朱泽智 雷鸣 (64)
小线圈常数的测量和校准	饶怡媛 鲁志荣 (66)
脉冲场下干扰信号的两种排除方法	蔡学榆 陈壬生 李传义 (70)
用低温核磁共振法测定超导磁体的磁场强度	
.....张钟华 王登安 龚树仁 于百江 朱凯 (73)	
低温核磁共振磁强计的建立	李世恕 王桂蓉 李山林 (77)

强磁场磁性

强磁场与物性研究(邀请报告)	杨伏明 (80)
----------------------	----------

- R₂Fe₁₄B四方相各向异性的初步探讨……胡伯平 陆珉华 赵汐潮 张寿恭 (80)
 Nd-Fe-B和Y-Fe-B 化合物的磁各向异性……………杨伏明 赵汐潮 赵汝文 于志弘 张寿恭 周希坚 孙天铎 (82)
 用不同工艺条件制备的高矫顽力2:17型稀土钴永磁合金反磁化过程的研究……………赵汐潮 杨伏明 罗 宏 于志弘 (86)
 各向异性 Mn-Al-C 永磁合金的磁性……………史振华 周运宽 杨伏明 赵汐潮 (89)
 低温强磁场下的磁性研究……………刘尊孝 兰 健 李国忠 (94)
 取代 GGG 单晶的磁化率……………李靖元 樊世勇 刘品清 (99)
 Nd₂B(Fe_{1-x}Co_x)₁₄相的磁性……………孙天铎 周希坚 杨伏明 赵汐潮 (101)
 多次导数 $\frac{d^n M}{d H^n}$ 测量的一个可能方法……………胡洪铨 (104)

强磁场输运性质

- 强磁场超导材料 (邀请报告) ………………李传义 尹道乐 (105)
 超导体临界电流的脉冲场测量……………蔡学榆 李传义 尹道乐 (111)
 Nd₃Ge临界场Hc₂的测量……………高瑞芬 朱泽智 徐 宁 (115)
 GaAs-Al_xGa_{1-x}As 异质结界面中二维电子系统磁声子效应的共振结构……………吴永生 周钧铭 黄 纯 杨伏明 赵汐潮 (117)
 强磁场中二维电子系统的SdH振荡及量子化 Hall 效应……………郑厚植 程文超
 ………………朱泳堂 王杏华 李月霞 杨富华 毕可奎 李承芳 江丕桓 (119)
 非晶态 Y_{0.05}-Ni_{0.95} 合金膜的霍尔效应……王亦忠 冯敏英 龚 伟 王震西 (123)

脉冲强磁场的设计理论和实验

(邀请报告)

张裕恒

(中国科学技术大学物理系)

提 要

本文评述了各种高强和超强脉冲磁场发生器。介绍我们提出的脉冲强磁场系统和电路系统最佳设计的理论和方法，并讨论了“磁通浓缩器”无浓缩磁通作用，因而用它产生高强磁场存在原理性的错误。

一、引 言

强磁场在工业、农业、医疗以及基础研究的各个领域中愈来愈得到广泛地应用，特别是随场值的提高其应用范围也随之扩大。产生磁场的方法概括说有三种：常规大功率水冷有阻磁体，超导磁体（包括混合磁体）以及瞬态的脉冲磁体。在低于10T的场值下，常规磁体和超导磁体由于其稳态的特点能具有一定的优越性，但常规磁体消耗能量太大，而超导磁体虽然耗能少，但要附加一套低温设备，因而成本都较高，假如以成本而论，在高于10T的情况下，常规、超导和脉冲场成本之比大约是100:10:1。况且稳恒场的常规、超导磁体都达不到20T，目前做到最高场值的由超导、正常导体绕制的混合磁体也只达到30T。因此大于30T的磁场发生器只有脉冲场能达到。

本文介绍并评述了各种高强和超强场的脉冲磁体。介绍我们提出的脉冲强磁场系统和电路系统最佳设计的理论和方法，指出合理的设计可大大的减少能源，并指出热效应不是影响脉冲场的主要原因。本文还从理论上讨论了“磁通浓缩器”无浓缩磁通作用，因而希望用之获得高强磁场存在原理性错误。

二、脉冲磁体的类型

自从1924年Kapitza [1] 建立第一个脉冲磁体以来，目前脉冲磁场发生器有如下种类：绕组线圈、Bitter线圈、单匝线圈、磁通浓缩器、电磁驱动磁通压缩器（角向和轴向）和爆炸驱动磁通压缩器。

通常我们称10T以下为强磁场；在10T到100T之间为高强场；大于100T为超强场。脉冲宽度大于10ms称长脉冲，小于1ms称短脉冲。一般绕组线圈可获得大于10ms，大于40T的场值；Bitter线圈在100 μ s量级已做到70T；可获得100T以上的单匝线圈、电磁驱动器和爆炸发生器都是 μ s或小于 μ s范围。

1. 绕组线圈

它是由长方矩截面的铜线绕制成的空心螺旋管，一般运行在液氮温度下，高水平的参数为内径20mm，脉冲宽度17.5ms、磁场值达51.7T^[2]。通常认为绕组线圈受到巨大的电磁力

在运行过程中发热的限制。当脉冲宽度大时，必然要求绕组的圈数增多，电感增大，这将导致场值的降低。见表1^[3]

表1

内径(mm)	匝 数	上升时间(ms)	脉冲宽度(ms)	最大场(T)
14	3600	120	300	17.0
14	1650	47	120	26.5
14	1160	35	80	31.0
14	800	22	48	34.5
14	800	21	46	36.0
14	600	16	36	40.0
14	400	8	19	46.5
14	300	6	15	51.0

电容组：23mF，2.5kV 72kJ

2. Bitter线圈

为了承受高场下巨大的电磁力，Bitter 提出一种螺旋形的线圈，见图 1。通常人们

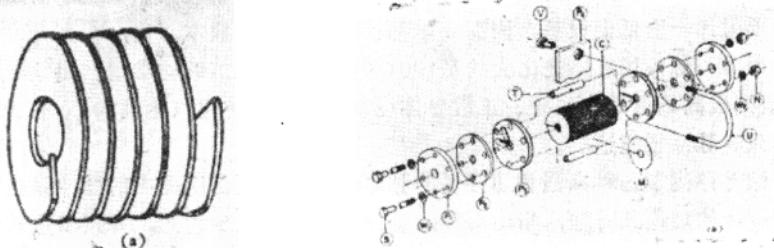


图1 Bitter线圈

(a) 示意图 (b) 装配图 B螺栓; w₁垫圈; p₁不锈钢后板; p₂绝缘板; p₃电极板; T绝缘导管; V螺环; p₄汇流板; C. Bitter 线圈; M. 单片; U. U形螺栓; W. 弹簧垫圈; N. 螺母

表2

结构			绕组		脉冲		能量	
内径 (mm)	外径 (mm)	长度 (cm)	每圈厚度 (mm)	总圈数	上升时间 (μs)	H _{max} (T)	电容器组 (kJ)	(kV)
38	76	60	3.2	16	400	24	75	4
19	76	60	3.2	15	240	55	75	4
6.3	2.5	20	0.75	19	80	70	9	3
20	41	70	1.27	48	210	20	12	5.3
15	36	77	1.0	64	160	22	9	3
32	100	50	1.25	23	50	28	—	11

称这种结构的线圈为Bitter线圈，这种结构有较好的整体性，固可承受较大的电磁力。表2给出其结构和运行参数^[3]。常用的材料是铍铜。

3 单匝线圈

为了获得百万高斯以上的磁场，必须解决两个问题：一是能在线圈中通入大电流，一是能承受巨大的电磁力。然而向线圈中供给电流不是只靠增加能源就能完成的，线圈的电感阻止电流的进入（见第三部分），显然线圈的电感愈小愈好，因此人们设计了单匝线圈，见图2，对于单匝线圈可以将壁做得很厚以克服运行过程中的电磁力。图2给出的单匝线圈电极十分宽大，这样电极的电阻很小，则在其上损耗小，以致能量尽可能多的供给线圈，下表给出此种脉冲发生器的结构、能量和运行参数^[3]。实验上Shearer^[4]得到了350T的最高磁场值，场再继续升高，发生器承受不了巨大的电磁力而断裂^[4]。

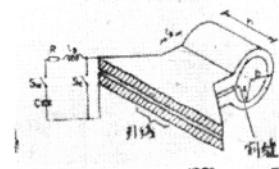


图2 电容器组供电的单匝线圈

结 构		脉 冲		能 量	
内径 (mm)	长度 (mm)	上升时间 (μs)	H _{max} (T)	(电容器组) (kJ)	(kV)
110	7700	5.2	2.5	1100	40
100	1500	9.5	18.0	2670	40
70	140	1.7	23.0	115	2×40
6	10	7	120.0	24	4
5	10	3.5	150.0	200	15
5	10	1.8	250.0	60	15
3.4	5.5	3.8	140.0	220	125
3	10	3.3	350.0	820	70

4. 磁通浓缩器

单匝线圈可获得百万高斯的超强场，但脉冲时间短，只有几微秒；用绕组线圈可以得到长脉冲，例如几十毫秒，但因其内层经受不住巨大的电磁力而使磁场值只能在50T以下，为了获得长脉冲的强场，Kim等^[5-8]提出了一个所谓磁通浓缩器作为高强长脉冲磁场发生器。图3给出其原理图。它是把一个有径向割缝的中空圆柱导体（文献上称为浓缩体）插入一个多匝绕组线圈中，后者被看作是初级，前者被看作是次级。当初级中通过脉冲电流时，沿着次级的内外边缘及割缝边缘就产生一个闭合电流，该电流使“浓缩体”区域中无磁通，这部分磁通被“挤”向中空区而产生强场^[5]。

显然这种结构的发生器存在两个损耗：一是初级和次级之间的耦合，二是存在二次热损耗，然而如果可以浓缩的话，它还是有利的。Srivastava^[8]设法提高它的耦合效应，从而获得约40T、120μs的脉冲场。但是我们注意到不管是文献^[8]，还是文献^{[5]—[7]}，所有的浓缩器获得的场值都远低于预想值。

5. 电磁驱动磁通压缩器

(1) θ压缩（角向压缩）

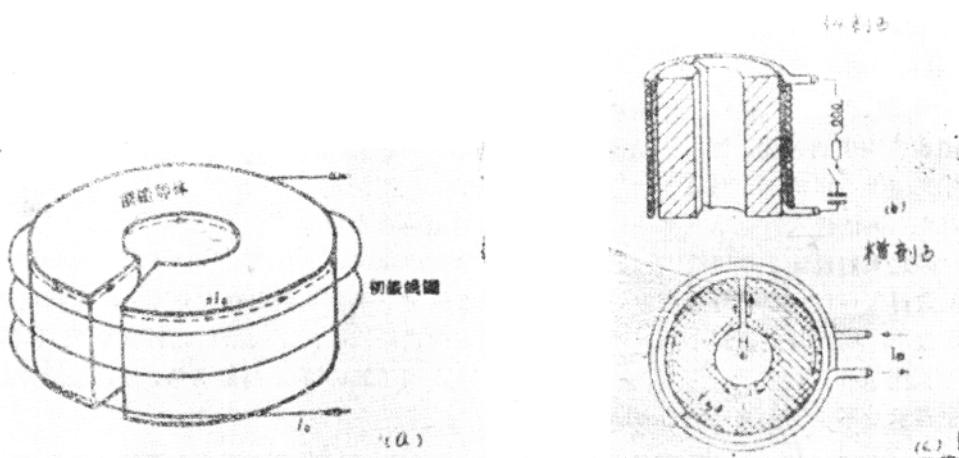


图3 磁通浓缩器
(a) 示意图 (b) 纵剖面, (c) 横剖面

图4是角向电磁驱动磁通压缩器的原理图。它是由两个同轴环柱组成，外面的环柱是单匝线圈，内闭合环柱是用壁厚为 $0.5\text{--}1\text{ mm}$ Al的圆筒。当单匝线圈通电时，在线圈空间产生磁场，由于内筒是Al，所以除了在Al筒中感应起环形电流外，外线圈产生的磁场仍然可以进入Al筒内，筒中的电流和磁场的作用产生向内的径向压缩力，以致Al筒变细，这个迅速向内收缩的过程将筒内的磁通压缩到小面积上，从而获得高场。

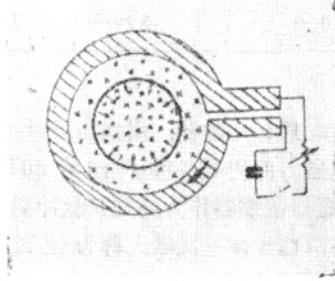


图4 角向电磁驱动磁通压缩器

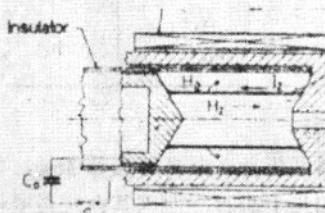


图5 轴向电磁驱动磁通压缩器

(2) z 压缩(轴向压缩)

图5是其原理图。初级线圈先产生一个磁场 H_z ，当接通电容器开关 S_w ，电流 I_1 在内部的铜筒中流动时， I_1 在筒外产生角向磁场 H_θ ， I_2 和 H_θ 产生的电磁力使铜筒内向收缩，产生一个压缩磁通，获得超强磁场。

表5^[3]给出能源、初始条件和压缩后的结果。

6. 爆炸驱动磁通压缩器

初级线圈在衬套内产生一个磁场，然后用定向爆炸使衬套径向收缩浓縮磁通产生超高场，

表5

	单位	θ 压缩	z 压缩
能 源			
电容器组的能量 W_{CB}	kJ	136	570
电容器组的电压 V_0	kV	20	4.8
最大电流 I_{max}	mA	0.64	4.9
放电时间 ($1/4T_0$)	μs	25	40
初始条件			
内筒材料		A1	Cu
内筒半径 R_1	mm	39.5	30
内筒壁厚 d_0	mm	0.8	2
内筒长度 l_0	mm	20	150
初场 H_0	T	~ 2.5	3.5
结 果			
最大压缩速度	mm/s	1.7	1.3
在 r_1/R_1 时的压缩速度	mm/s	1.5	0.7
总的压缩时间	μs	33	63
最大的测量场 H_m	T	110	280
相应于最大场的内半径 r_m	mm	3	3.3

爆炸法是获得千万高斯以上磁场的唯一手段。

图6 (a) 这个装置的一种，图6 (b) 拍照出了爆炸压缩的过程。表6给出世界上主要研究组的结果。

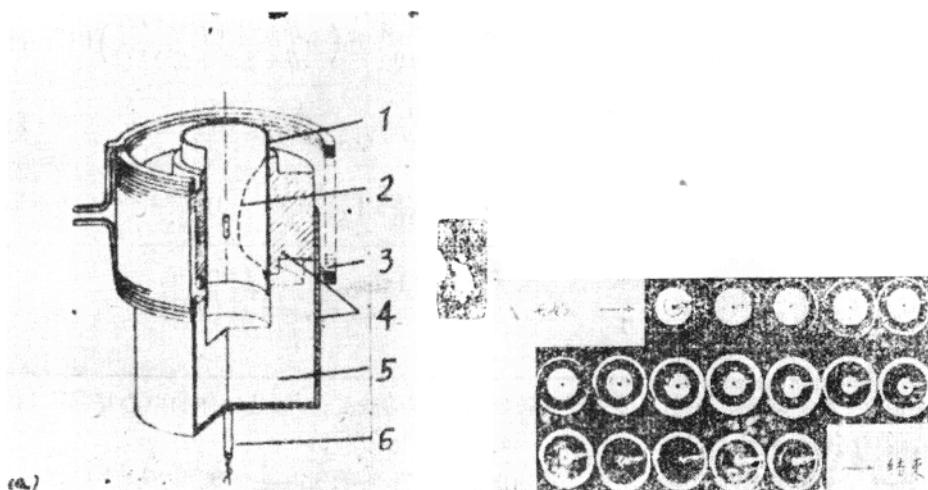


图6 爆炸驱动磁通压缩器 (a) 装置；(b) 压缩过程

1. 套筒 2. 爆炸后的筒 3. 线圈 4. 炸药 5. 支撑 6. 雷管

表6

地点,时间	衬套			初场		最后性能	
	外径 (mm)	内径 (mm)	材料	电容器组 H_0 W_{CB} (kJ)(T)	(T)	H_{max} (T)	r_{min} (mm)
Los Alamos 1966	38.1	34.9	黄Cu	30	9	1400	~ 2.5
	1966	54	52.4 不锈钢	300	3	500—600	~ 1.3
Moscow 1966	—	—	不锈钢(+20μCu)	—	—	2500	~ 2.0
	1966	—	150 Cu	—	~ 6	500	~ 1.5
Foulness 1967	53	5	Cu	—	8	350—500	—
Limeil 1967	42.5	41	不锈钢	200	5	500—700	~ 2.5
Frascati 1967	39.5	38.5	不锈钢	200	6.5	500—600	~ 2.5

三、脉冲强磁场系统和电路系统最佳设计的理论

上面我们介绍的各种类型磁场发生器都离不开绕组线圈或它的变形。只要线圈中能流过电流 i_0 , 磁场值就能够从理论上得出。1936年Bitter^[9]就给出了不同结构形状的产生场的理论公式, 见表7。

图7 对不同结构形状的磁体所产生场的Bitter公式

线圈形状	电流密度 i_0	磁场 ($a = \frac{a_2}{a_1}$, $\beta = \frac{b}{a_1}$)	备注
方截面	常数	$B_0 = \frac{4\pi b \lambda i_0}{10} \ln \frac{a_2 + (a_2^2 + b^2)^{1/2}}{a_1 + (a_1^2 + b^2)^{1/2}}$	绕组线圈
方截面	$\frac{i_0}{a}$	$B_0 = \frac{4\pi i_0 \lambda}{10} \ln \left(\frac{a \beta + (1 + \beta^2)^{1/2}}{\beta + (\alpha^2 + \beta^2)^{1/2}} \right)$	Bitter线圈
锥形截面	常数	$B_0 = \frac{4\pi i_0}{10} \frac{\lambda k}{(1 + k^2)^{1/2}} (\alpha_2 - \alpha_1)$	$b = k\alpha$
锥形截面	$\frac{i_0}{a}$	$B_0 = \frac{4\pi i_0 \lambda}{10} \left(\frac{k}{k^2 + 1} \right)^{1/2} \ln \frac{a_2}{a_1}$	$b = ka$
方截面	最佳的径向分布 $i_0 = f(a) = \frac{1}{20\mu\rho a (a^2 + b^2)^{1/2}}$	$B_0 = \frac{4\pi b \lambda}{10} \int_{a_1}^{a_2} \frac{f(a) da}{(a^2 + b^2)^{1/2}}$	

a_1 是磁体内半径; a_2 是磁体外半径; $2b$ 是磁体的长度; B_0 是磁体的中心场强; λ 是填充因子; i_0 是流过磁体材料的电流密度。

然而, 任何线圈都是有电感的, 脉冲电流的大小将受到电感限制。

1. 绕组线圈

图7是脉冲磁体工作电路示意图。如果 $R_1 = R$, 电路总电感 $L_1 =$ 线圈电感 L , 在

$R < 2\sqrt{L/C}$ 的条件下，

$$I = \frac{V}{L\omega_0} e^{-\alpha t} \sin \omega_0 t \quad (1)$$

$$\alpha = \frac{R}{2L}, \quad \omega_0 = (\omega^2 - \alpha^2)^{\frac{1}{2}}, \quad \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

V 是电容器的工作电压。

$$\text{令 } \frac{\partial s}{\partial t} = 0$$

$$\text{得 } t_m = \frac{1}{\omega_0} \tan^{-1} \frac{\omega_0}{\alpha} \quad (2)$$

t_m 则是达到电流最高峰值的时间，所以

$$I_{\max} = \frac{V}{L\omega_0} \exp \left(\frac{\alpha}{\omega_0} \tan^{-1} \frac{\omega_0}{\alpha} \right) \sin \tan^{-1} \frac{\omega_0}{\alpha} \quad (3)$$

从(3)式看到 L 大就会达不到所希望的电流，因此减小 L 看来是有利的。这个结论在不要求放电时间的情况下是正确的。但如果要求满足某个时间常数 T ，也就是 T 作为一个磁体所必须达到的参数的话， L 应有适当的值。因为

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \left(\frac{1}{LC} + \frac{R^2}{4L^2} \right)^{-\frac{1}{2}} \quad (4)$$

如果 L 小，则必须增加 C ，从公式(1)或(3)我们看到 C 的增加，电流只按 \sqrt{C} 增加，显然这是不利的。如何选取适合的 L ，过去没有理论上的依据，只凭经验判断。因为设计磁体只是根据表 7 中的公式，例如对于矩形截面绕组线圈

$$B_0 = \mu_0 i_0 \lambda F(a, \beta) \times 10^{-6} \quad (5)$$

$$\text{式中 } F(a, \beta) = \frac{4\pi}{10} \beta \ln \frac{a + (a^2 + \beta^2)^{1/2}}{1 + (1 + \beta^2)^{1/2}} \quad (6)$$

$$\lambda = \frac{\text{导体的有效体积}}{\text{磁体结构的总体积}}$$

$$= \frac{IS}{2\pi(a_2^2 - a_1^2)b} \quad (7)$$

I 是线长度， S 是线截面积，(7) 式只要求 IS 是定值即可，而 S 选多大为佳也是没有理论根据的。

我们^[10]注意到，如果给定线圈的匝数 N ，则

$$I = N\pi(a_1 + a_2) \quad (8)$$

而磁体结构确定后，只要给出匝数，则线圈的电感 L 就是确定值。

$$L = \mathcal{L}_c N^2 \quad (9)$$

$$\mathcal{L}_c = \left(\frac{\mu_0}{4\pi} \right) 4\pi a_0 \left(1 + \frac{b^2}{8a_0^2} + \frac{c^2}{96a_0^2} \right) \ln \frac{a_0}{d_0} - y_1 + \begin{cases} \frac{c^2}{16a_0^2} y_2 & c > 2b \\ \frac{b^2}{4a_0^2} y_2 & c < 2b \end{cases}$$

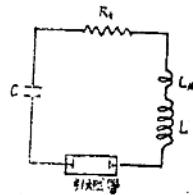


图7 脉冲磁体工作电路示意图
 R_t 为总电阻， $L_t = L$ 外 + L

式中 $a_0 = \frac{1}{2}(a_1 + a_2)$, $c = a_2 - a_1$, $d_0 = (4b^2 + c^2)^{\frac{1}{2}}$, y_1 , y_2 , y_3 是修正分数, 可以查表得到。

由(4)式和(9)式看到电路参数和结构参数是有密切联系的。而(4)式中的电阻 R 为

$$R = \rho \frac{l}{S}$$

此外, 在磁体结构和电路确定之后, I_{\max} , 还满足

$$I_{\max} = i_0 S \quad (11)$$

给定 i_0 , 材料中所受的应力密度 σ 如取自由值公式则有

$$\sigma = a_1 i_0 B_0 \quad (12)$$

如果给定设计指标 B_0 , $2a$, $\frac{1}{2}T$, σ , λ 和 V , 则由方程(3)~(12)组成一个完备方程组, 可解出 i_0 , $F(a, \beta)$, a_2, b, L, C, N, l, S, R 和 I_{\max} 等11个未知数的解析式^[10]。在解上述10个方程组时还用了要求绕组最小体积方程, 故总共是11个方程11个未知数, 方程解是唯一的。有时为了要求磁体有一定均匀度而把 b 也做为一个设计参数。

2. Bitter线圈

Bitter线圈中流过的电流密度与线圈的半径成反比, 它的设计理论和上述略有不同, 首先场的公式是用表7中Bitter线圈的公式, 电感也应取相应的Bitter线圈的电感公式, 如 $L = \mathcal{L}_B N^2$, 其次, 它的线宽 t 就是 $a_2 - a_1$, 上述的截面 S 在这里应换成 $d(a_2 - a_1)$ 。在计算它的电阻时, 线的长度 l 无意义, 因此不存在 l 的方程, 当然也不能用(10)式求电阻。此外 λ 也和上述不同, Bitter线圈 λ 是

$$\begin{aligned} \lambda &= \frac{\pi(a_2^2 - a_1^2)\alpha N}{\pi(a_2^2 - a_1^2)2b} = \frac{dN}{2b} \\ d &= \frac{2\lambda b}{N} \end{aligned} \quad (13)$$

为了计算Bitter线圈的电阻, 我们考虑一个单匝, 在环上半径为 r 处取面元 $2\pi r dr$, 设面元的电阻为 dR_1 , 则每匝线的电阻 R_1 将由

$$dR_1 = \rho \frac{2\pi r}{ddr}$$

$$\text{即 } d\sigma_{\text{电}} = \frac{d}{2\pi\rho} \frac{dr}{r}$$

求出。

$$\begin{aligned} \sigma_{\text{电}} &= \int_{a_1}^{a_2} \frac{d}{2\pi\rho} \frac{dr}{r} = \frac{d}{2\pi\rho} (\ln a_2 - \ln a_1) \\ R_1 &= \frac{2\pi\rho}{d(\ln a_2 - \ln a_1)} \end{aligned} \quad (14)$$

则由方程(3)~(6), $L = \mathcal{L}_B N^2$, 方程(11)~(14)和体积最小解求10个未知数 i_0 , $F(a, \beta)$, a_1 , b , L , C , N , d , R_1 , I_{\max} 即得到Bitter线圈一整套完整的设计。

3. 单匝线圈

由于单匝线圈 $N = 1$, $\lambda = 1$, 所以Bitter线圈10个未知数10个方程就变成了9个未知数10个方程, 那么其中一个未知数必然不是唯一的。但是单匝数线圈一般只是为了获得高场值, 而对时间常数 $\frac{1}{2}T$ 不作要求, T 是任意的, 因此方程(4)可以去掉, 从而得到唯一解。

4. 最佳设计

从上面理论分析可以看到强力密度 σ 作为参量必定有电容 C 与 σ 的关系

$$C = f(\sigma) \quad (14)$$

从定性上看, 给定 σ , 由(12)式看到 i_0 就定了, σ 大, i_0 大。再由(5)式和(6)式知道, i_0 , $F(a, \beta)$ 小, 则 a_2 小, 为了达到给定的 L , (9)式给出必须增加 N , 这样将要求线材的截面积小, 以致总的 R 增加, 其结果是焦耳损耗大。但是由于 a_2 小, 则在 $a_2 - a_1$ 范围内的磁能损失小; 而如果 σ 小, 则 a_2 大, S 大, 焦耳损耗小, 这样将伴随着在 $a_2 - a_1$ 上的磁能损失大。因此, 在线圈本体中的磁能损失和焦耳损耗有一个竞争, 其结果必然导致存在一个适合的 σ 以使 C 最小。从上述分析看到(15)式一定存在一个极值。由

$$\frac{\partial C}{\partial \sigma} = 0 \quad (16)$$

可以得到相应于 C 极小值的 σ_m 。不过由于(16)式很难给出解析解, 所以我们用数值求解

表8 绕组线圈最佳设计的理论值

设计指标	B_0 (kG)	60	60	60	60	60
	$t_m \times 10^{-3}$ (sec)	20	20	20	20	20
	$a_1 \times 10^{-2}$ (m)	6.45	6.45	6.45	6.45	6.45
已知参数	λ	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	V (kV)	5	5	5	5	5
	$\sigma \times 10^8$ (N/m ²)	1.0	1.5	2.0	2.5	4.0
	$\rho \times 10^{-8}$ (Ω·m)	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64
磁体结构和电源参数的计算值	$F(a, \beta)$	0.903	0.60	0.45	0.36	0.225
	$a_2 \times 10^{-2}$ (m)	14.2	11.2	9.66	9.03	8.06
	$b \times 10^{-2}$ (m)	8	8	8	8	8
	$l \times 10^2$ (m)	2.3	2.36	2.405	2.19	1.77
	$S \times 10^{-6}$ (m ²)	13.8	7.2	4.35	3.67	2.66
	N	354	422.5	475	448	386
	$R \times 10^{-1}$ (Ω)	2.68	5.4	9.1	9.8	10.9
	$L \times 10^{-8}$ (H)	15.13	17.2	18.0	16.55	11.63
	$i_0 \times 10^8$ (A/m ²)	2.58	3.88	5.165	6.46	10.33
	$I_{max} \times 10^3$ (A)	3.56	2.785	2.24	2.37	2.75
	$C \times 10^{-8}$ (F)	10.71	9.41	8.575	9.72	13.92